中子活化后放射性核素半衰期测量

赵宇航

摘要: 本实验测定了In中子活化后放射的粒子数,从而确定其半衰期,并就研究合理性进行了讨论。

1 实验目的

- 1. 掌握中等寿命的放射性核素半衰期(天、时、分、秒数量级)的测定方法。
 - 2. 了解产生人工放射性核素的基本知识。
 - 3. 学会使用多功能数字多道的多定标功能。

2 实验原理

2.1 半衰期的测定

半衰期是放射性原子核的一条重要的基本性质,每种核素都有它特有的半衰期,因此测定半衰期和测定原子核质量一样,可以用于鉴别原子核。半衰期对研究放射性原子核有重要意义,由半衰期可以确定跃迁级次或多级性。在生产和应用放射性核素时,也需要了解其半衰期对放射性生长或衰变的关系,才能适当的掌握照射时间和不失时机的使用放射性核素。

不同放射性核素半衰期差别很大(从10⁻¹¹秒到10¹¹年),不同范围的半衰期测量方法各不相同。ms 以下的短半衰期用核电子学的延迟符合等方法测量。10年以上的长半衰期用比放射性的方法测量。中等半衰期则可以通过测量衰变曲线求得,本实验测量^{116m}In 的半衰期就是这一范围的放射性核素半衰期。对于单一放射性核素,仪器得到的计数率随时间的变化为

$$n(t) = n(0)e^{-\lambda t} \tag{1}$$

 $n(0)(\vec{u}n_0)$ 为开始测量时的计数率,n(t)为开始测量后 t 时刻的计数率, λ 为衰变常数,衰变常数和半衰期 $T_{1/2}$ 的关系为

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \tag{2}$$

由计数率的指数衰变规律可得

$$ln \ n(t) = ln \ n(0) - \lambda t \tag{3}$$

计数率的对数和时间有如图 6-1的直线关系,用目测作图或者最小二乘法拟合直线可得 $-\lambda$,再算得 $T_{1/2}$ 。

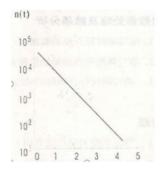


图 6-1 单一放射性核素衰变图

由于实际上不能测到 t 时刻的计数率 n(t),测到的只能是某一时间间隔 $\triangle t = t_2 - t_1$ 的计数 N,再由 $N/\triangle t$ 求得平均计数率 \overline{n} , \overline{n} 和 n(t) 的关系为

$$\overline{n} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} n(t)dt = \frac{n(0)}{\lambda(t_2 - t_1)} (e^{-\lambda t_1} - e^{-\lambda t_2})$$
(4)

可将n看作t'时刻的计数率n(t'),即

$$n(0)e^{-\lambda t'} = \overline{n} = \frac{n(0)e^{-\lambda t_1}[1 - e^{-\lambda(t_2 - t_1)}]}{\lambda(t_2 - t_1)}$$
 (5)

可得到t'和t₁的关系为

$$t' = t_1 - \frac{1}{\lambda} \ln \frac{1 - e^{-\lambda(t_2 - t_1)}}{\lambda(t_2 - t_1)}$$
 (6)

$$t' = t_1 - \frac{1}{\lambda} ln[1 - \frac{1}{2}(\lambda \triangle t) + \frac{1}{6}(\lambda \triangle t)^2]$$
 (7)

进一步展开ln(1-x) 可得

$$t' = \frac{t_1 + t_2}{2} - \frac{1}{24}\lambda \triangle t^2 \approx \bar{t} - 0.0289 \times \triangle t \times (\frac{\triangle t}{T_{1/2}})$$
(8)

若测量过程控制得好, 使

$$0.0289 \times \triangle t \times (\frac{\triangle t}{T_{1/2}}) \gg \bar{t} \tag{9}$$

就可以用n来表示 $\bar{t} = \frac{t_1 + t_2}{2}$ 时刻的计数率。在综合考虑上述简化原理和 $\triangle t$ 测量时间中计数的统计误差后,选取适当的 $\triangle t$,可以用 $\bar{t} = \frac{t_1 + t_2}{2}$ 代替t'。

2.2 生产放射性核素的一般知识

将稳定核素 A 放在带电粒子或者中子流中辐照,产生核反应

$$A + a \rightarrow B + b$$

剩余核素 B 可能是放射性的。若剩余核素的衰变常数为 $-\lambda$,则在恒定的入射粒子通量 ϕ 下,放射性核素 B 活度 A(t)按

$$A(t) = \phi \sigma N_1 (1 - e^{-\lambda t}) \tag{10}$$

规律生长,其中 σ 是该反应的反应截面(称为活化截面),Nt为样品中稳定核素A 的总数, $A(\infty) = \phi \sigma N_1$ 为饱和活度,表 1 给出了产生的活度和辐照时间 t 的关系。可以根据生产核素的半衰期和辐照条件权衡确定辐照时间。

表1A随t的变化关系

t=nT _{1/2}	0. 5T _{1/2}	1T _{1/2}	2T _{1/2}	3T _{1/2}	4T _{1/2}	5T _{1/2}	6T _{1/2}
A(t)	0. 293A(∞)	0.5A(∞)	0.75A(∞)	0.875A(∞)	0.938A(∞)	0.969A(∞)	0.985A(∞)

天然铟的同位素丰富度及活化反应有关的数据列于表 2。当被激活样品中存在两种独立的放射(6)性核素时,衰变曲线上的计数率是两种放射性核素的计数率之和

$$n(t) = n_1(t) + n_2(t) = n_1(0)e^{-\lambda_1 t} + n_2(0)e^{-\lambda_2 t}$$
(11)

(7) 如图 6-1 表示。由总衰变曲线定出较长半衰期 $\Phi T_{1/2}$)₂,然后从 n(t) 中扣除 $n_2(t)$,求出 $n_1(t)$,再得到 $\Phi T_{1/2}$)₁。铟活化后生成五种放射性核素和同质异能素,由于同质异能素^{116m} In 的半衰期和其他四种放射性核素半衰期相差 1-2 个数量级以上,适当选择活化辐照时问和"冷却时间"(即从停止辐照到开始测量活性的时间),可以使其它四种放射性对^{116m} In 半衰期测量的影响很小,故而可以用单一放射性半衰期的规律处理数据。

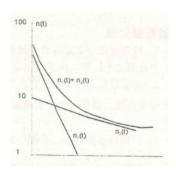


图 6-2 两个独立放射性核素混合衰变曲线

表 2 天然铟中子活化的各种参**数**

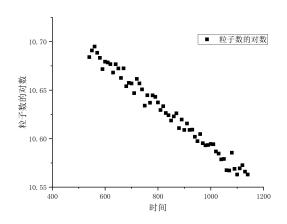
同位素丰度	¹¹³ In 4.28%		¹¹⁵ In 95.72%			
活化后剩余核	¹¹⁴ In	^{114m} In	¹¹⁶ In	116mIn	^{116m} In	
热中子活化截面	3.9b	4.4b	45b	65b	92b	
剩余核半衰期	71.9s	50 天	14.2s	54.1min	2.16s	

3 实验结果

前后两个本底段计算出平均本底计数分别 为19.83,20.33。总平均20.08,取20。

3.1 图解法

由于实验中中子活化后立即开始了测量,我们 去除前九分钟的数据。考虑到外界干扰,已删除不 合理的过高计数。对所测粒子数取对数作图如下所 示



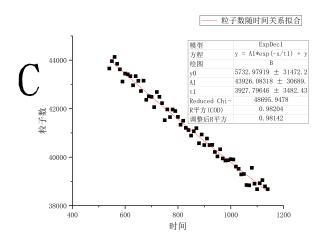
通过目测,可知其斜率大约是 2.2×10^{-4} ,利用式(2)可知其半衰期为52.5分钟。

3.2 最小二乘法

运用公式

$$y = y_0 + Ae^{-x/t_0} (12)$$

其中,半衰期 $T_{1/2}=t_0ln2$ 。用Origin拟合结果如下图所示

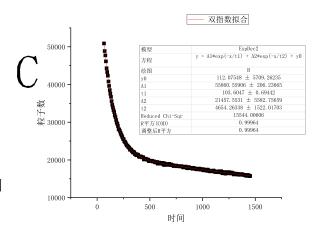


可以算出半衰期及其误差 $T_{1/2} \pm \Delta T_{1/2} = 45 \pm 40$ 分钟。

可见其误差过大,考虑到实验设备涨落太大而 所选实验数据太少。我们结合*In*的衰变原理,只 去除前一分钟的数据,把¹¹⁴*In*的放射也考虑进来,

使用下式进行拟合

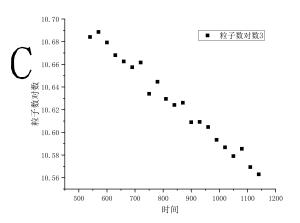
$$y = y_0 + A_1 e^{-x/t_1} + A_2 e^{-x/t_2}$$
 (13)

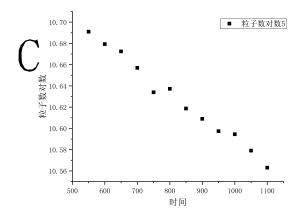


如上图所示,可知In半衰期及其误差 $T_{1/2}$ ± $\Delta T_{1/2}$ = 54 ± 18分钟。本底的误差相对这个值很小,我们忽略不计。

3.3 间断多定标谱

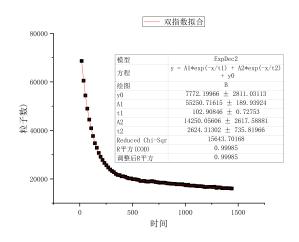
活性测量间隔为 3 道,二次活性测量时间间隔为 5 道,起始测量时间为 80 道。两次测量图解法如图

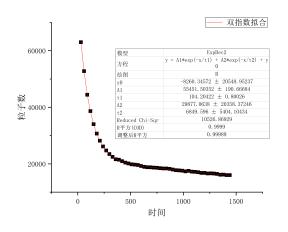




两次次斜率分别为 2.17×10^{-4} , 2×10^{-4} 。利用式(2)分别求其半衰期为53.3分钟、57.8分钟。

活性测量间隔为 3 道,二次活性测量时间间隔为 5 道,起始测量时间为 10 道。双指数拟合如下图所示





可以算出半衰期及其误差 $T_{1/2} \pm \Delta T_{1/2} = 43 \pm 12$ 分钟和 79 ± 62 分钟。属实不能随便删点,虽然54仍然在区间之内,但误差太大。

第一道和最后一道不取是因为开始测量可能 产生干扰场,对数据影响较大。

4 讨论

4.1 单一半衰期处理的可靠性

取活化时间为 3 个 ^{116m}In 半衰期,即162.3min。 由表1及式(11)分别计算In活度,注意到 ^{114}In 近乎完全激活,设其活度为 $3.9 \times 0.0428 = 0.16692$ 。依次得 ^{114m}In 活度0.010, ^{116}In 活度43.074, ^{116m}In 活度54.4408 和88.0624

由表2, 我们直接以相对活度求差, $t \in (10min, 118.2min)$ 。

$$A = 2^{-\frac{t_2}{T_{1/2}}} - 2^{-\frac{t_2}{T_{1/2}}} \tag{14}$$

依次求得: ^{114}In 所占活性为 5.1×10^{-4} , ^{114m}In 所占活性为 1.0×10^{-5} , ^{116}In 所占活性为 8.2×10^{-12} , ^{116m}In 所占活性为35.88979和 2.1×10^{-82} 。

那么实验所测 ^{116m}In 活性占比为99.9985%。

4.2 具体措施

增加了铅片,屏蔽了一些外界干扰。测量多道,减少统计误差。 $\lambda \triangle t = \lambda (t_1 - t_2) \gg 1$ 的条件下,可以用 $\overline{t} = \frac{t_1 + t_2}{2}$ 代替t'。

测量了两次本底取平均值,减少误差。在衰变 曲线中扣除了本底。本身误差比较大,所以本底误 差没那么重要。